

关键指标

- 射频&本振频率: 1.2~2GHz
- 中频频率: DC~1GHz
- 本振功率: 13dBm
- 变频损耗: 8.5dB
- LO/RF 隔离度: 45dB
- 芯片尺寸: 1.4mm×0.94mm

产品简介

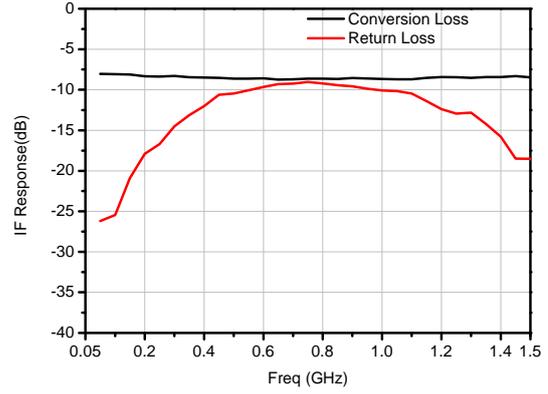
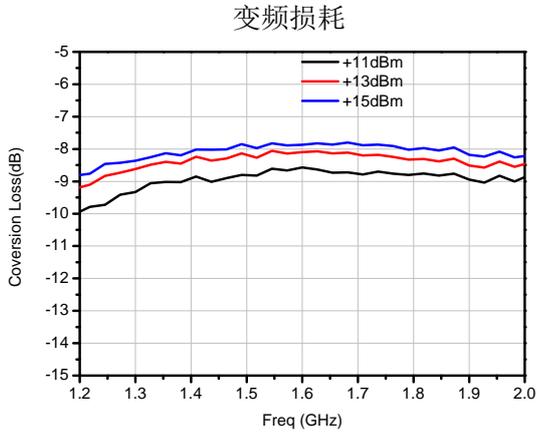
HG122HB 是一款无源双平衡混频器芯片, 射频和本振频率为 1.2~2GHz, 中频频率为 DC~1GHz, 变频损耗为 8.5dB。

电性能 (T_A=25°C)

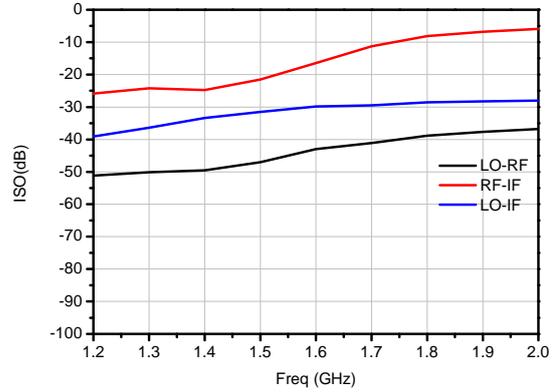
指标	最小值	典型值	最大值
RF&LO 频率(GHz)	1.2~2		
IF 频率(GHz)	DC~1		
变频损耗(dB)	—	8.5	—
LO~RF 隔离度(dB)	—	45	—
LO~IF 隔离度(dB)	—	30	—
RF~IF 隔离度(dB)	—	15	—
输入 1dB 压缩点(dBm)	—	12	—

典型测试曲线

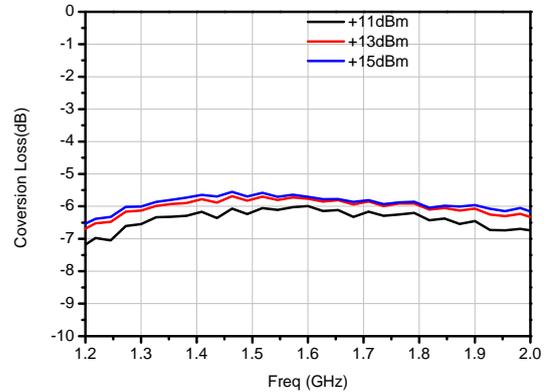
未注明情况下 IF=100MHz



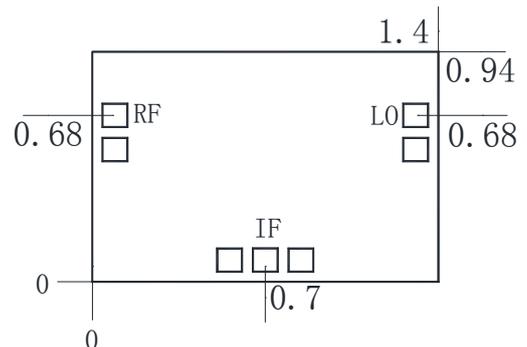
隔离度



上变频损耗

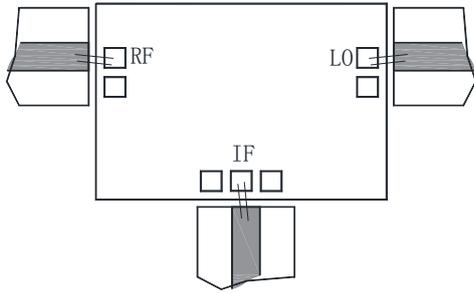


外形和端口尺寸 (mm)



中频带宽 IF:50~1500 MHz, RF:1.6GHz
LO:1.65-3.1GHz

推荐装配图



绝对额定最大值

最大输入功率	+20dBm
工作温度	-55℃~125℃
存储温度	-65℃~150℃

注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 300℃，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用 $\Phi 25\mu\text{m}$ 双金丝键合，建议金丝长度 250~400 μm ；
5. 芯片输入输出端均无隔直电容；
6. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。